



DP10N60

N 沟道增强型场效应晶体管
N-CHANNEL MOSFET

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

I_D	10 A
V_{DS}	600 V
$R_{DS(on)}$ -max ($V_{GS}=10V$)	0.85 Ω
Qg-Typ	51.5 nC

用途 APPLICATIONS

- 高频开关电源 High efficiency switch mode power supplies
- 电子镇流器 Electronic lamp ballasts based on half bridge
- LED 电源 LED power supplies

产品特性 FEATURES

- 低栅极电荷 Low gate charge
- 低 C_{rss} (典型值 16.9pF) Low C_{rss} (typical 16.9pF)
- 开关速度快 Fast switching
- 产品全部经过雪崩测试 100% avalanche tested
- 高抗 dv/dt 能力 Improved dv/dt capability
- RoHS 产品 RoHS product

订货信息 ORDER MESSAGE

订货型号 Order codes	印记 Marking	封装 Package	无卤素 Halogen Free	包装 Packaging
DP10N60	DP10N60	TO-220C	是 YES	条管 Tube

封装 Package

